

Darlington Amplifier Transistors

- We declare that the material of product compliance with RoHS requirements.

ORDERING INFORMATION

Device	Marking	Shipping
LMBTA13LT1G	1M	3000/Tape & Reel
LMBTA14LT1G	1N	3000/Tape & Reel
LMBTA13LT3G	1M	10000/Tape & Reel
LMBTA14LT3G	1N	10000/Tape & Reel

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
Collector–Emitter Voltage	V_{CES}	30	Vdc
Collector–Base Voltage	V_{CBO}	30	Vdc
Emitter–Base Voltage	V_{EBO}	10	Vdc
Collector Current — Continuous	I_C	300	mAdc

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Total Device Dissipation FR– 5 Board, (1) $T_A = 25^\circ\text{C}$	P_D	225	mW
Derate above 25°C		1.8	mW/ $^\circ\text{C}$
Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	556	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Total Device Dissipation Alumina Substrate, (2) $T_A = 25^\circ\text{C}$	P_D	300	mW
Derate above 25°C		2.4	mW/ $^\circ\text{C}$
Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	417	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Junction and Storage Temperature	T_J, T_{stg}	–55 to +150	$^\circ\text{C}$

DEVICE MARKING

LMBTA13LT1G = 1M; LMBTA14LT1G = 1N;

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.)

Characteristic	Symbol	Min	Max	Unit
----------------	--------	-----	-----	------

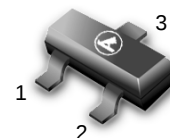
OFF CHARACTERISTICS

Collector–Emitter Breakdown Voltage ($I_C = 100 \mu\text{Adc}$, $V_{BE} = 0$)	$V_{(BR)CEO}$	30	—	Vdc
Collector Cutoff Current ($V_{CB} = 30\text{Vdc}$, $I_E = 0$)	I_{CBO}	—	100	nAdc
Emitter Cutoff Current ($V_{EB} = 10\text{Vdc}$, $I_C = 0$)	I_{EBO}	—	100	nAdc

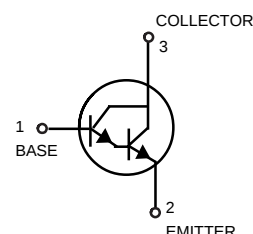
1. FR–5 = $1.0 \times 0.75 \times 0.062$ in.

2. Alumina = $0.4 \times 0.3 \times 0.024$ in. 99.5% alumina.

LMBTA13LT1G
LMBTA14LT1G



SOT–23



LMBTA13LT1G LMBTA14LT1G

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted) (Continued)

Characteristic	Symbol	Min	Max	Unit
ON CHARACTERISTICS (3)				
DC Current Gain ($I_C = 10\text{ mAdc}$, $V_{CE} = 5.0\text{ Vdc}$)	h_{FE}	5,000	—	—
	LMBTA13	5,000	—	—
	LMBTA14	10,000	—	—
($I_C = 100\text{ mAdc}$, $V_{CE} = 5.0\text{ Vdc}$)	h_{FE}	10,000	—	—
	LMBTA13	10,000	—	—
	LMBTA14	20,000	—	—
Collector–Emitter Saturation Voltage ($I_C = 100\text{ mAdc}$, $I_B = 0.1\text{ mAdc}$)	$V_{CE(sat)}$	—	1.5	Vdc
Base–Emitter On Voltage ($I_C = 100\text{ mAdc}$, $V_{CE} = 5.0\text{ Vdc}$)	V_{BE}	—	2.0	Vdc

SMALL–SIGNAL CHARACTERISTICS

Current – Gain–Bandwidth Product(4) ($V_{CE} = 5.0\text{ Vdc}$, $I_C = 10\text{ mAdc}$, $f = 100\text{ MHz}$)	f_T	125	—	MHz
--	-------	-----	---	-----

3. Pulse Test: Pulse Width $\leq 300\text{ }\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2.0\%$.

4. $f_T = |h_{fe}| * f_{test}$.

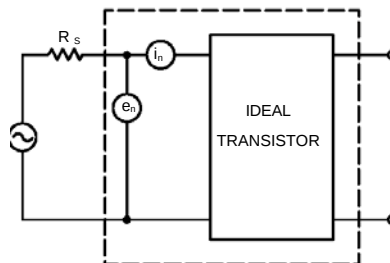


Figure 1. Transistor Noise Model

LMBTA13LT1G LMBTA14LT1G

NOISE CHARACTERISTICS

($V_{CE} = 5.0 \text{ Vdc}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$)

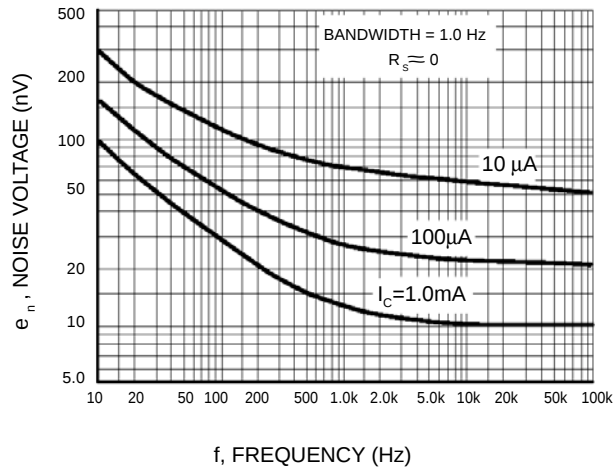


Figure 2. Noise Voltage

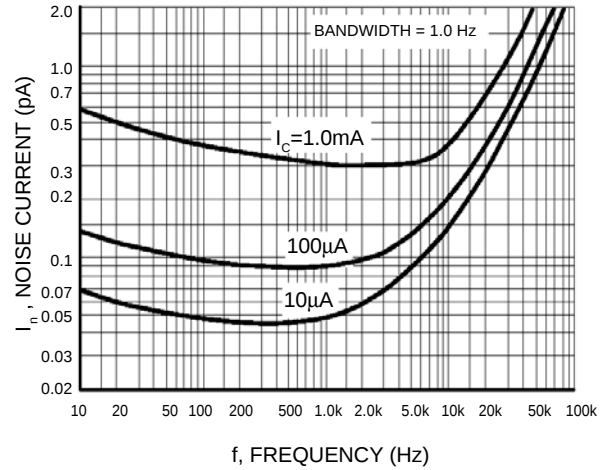


Figure 3. Noise Current

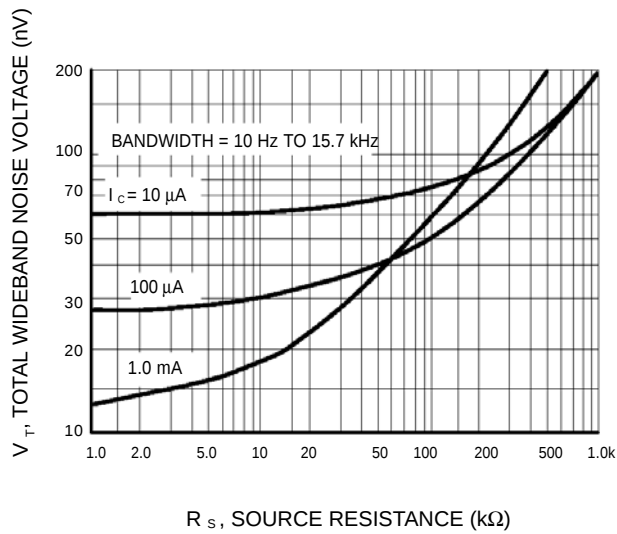


Figure 4. Total Wideband Noise Voltage

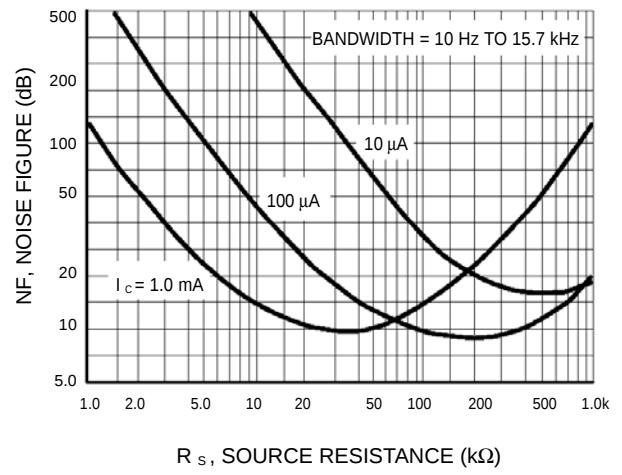


Figure 5. Wideband Noise Figure

LMBTA13LT1G LMBTA14LT1G

SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS

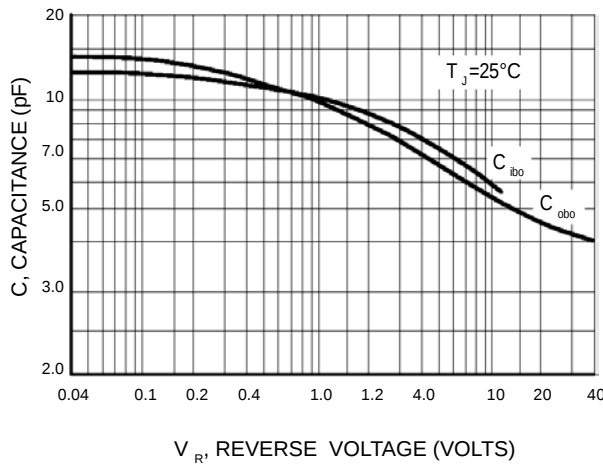


Figure 6. Capacitance

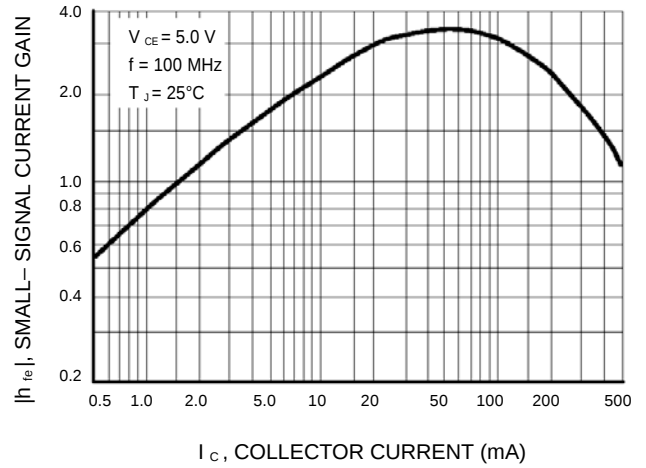


Figure 7. High Frequency Current Gain

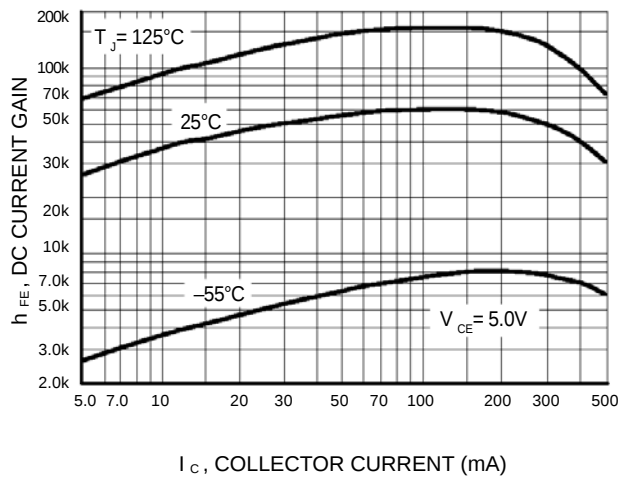


Figure 8. DC Current Gain

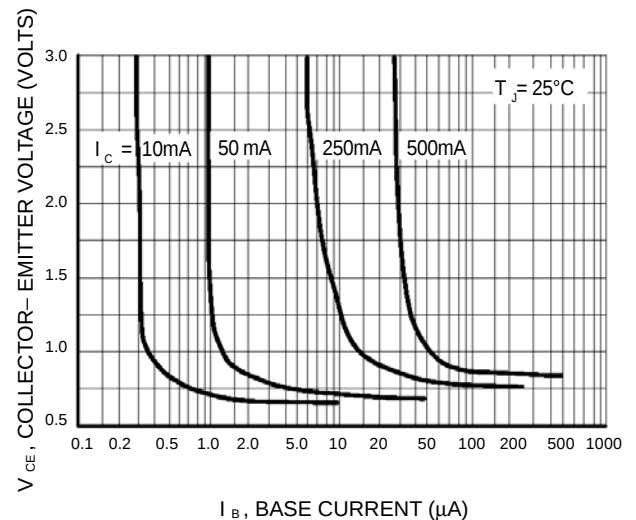


Figure 9. Collector Saturation Region

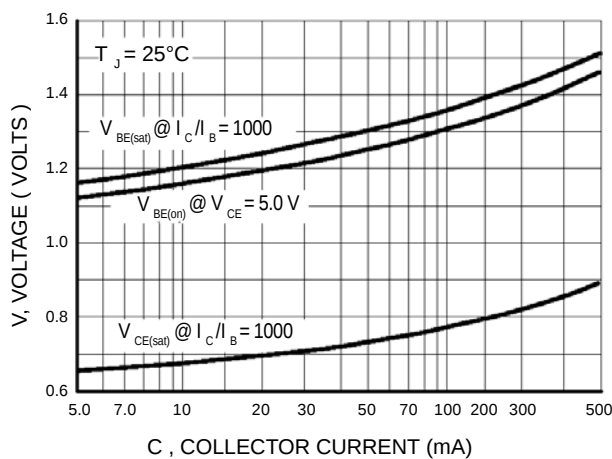


Figure 17. "ON" Voltages

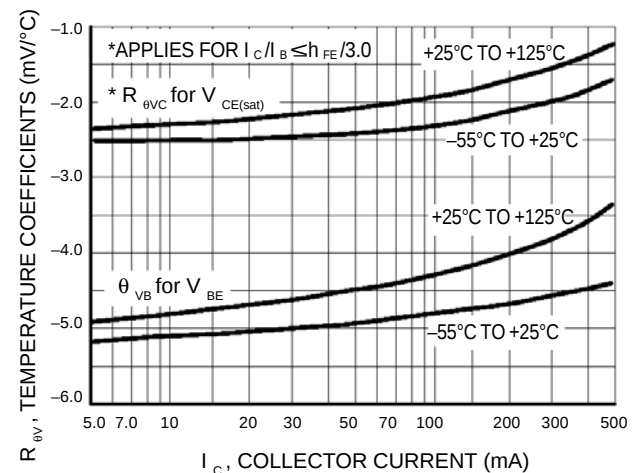


Figure 18. Temperature Coefficients

LMBTA13LT1G LMBTA14LT1G

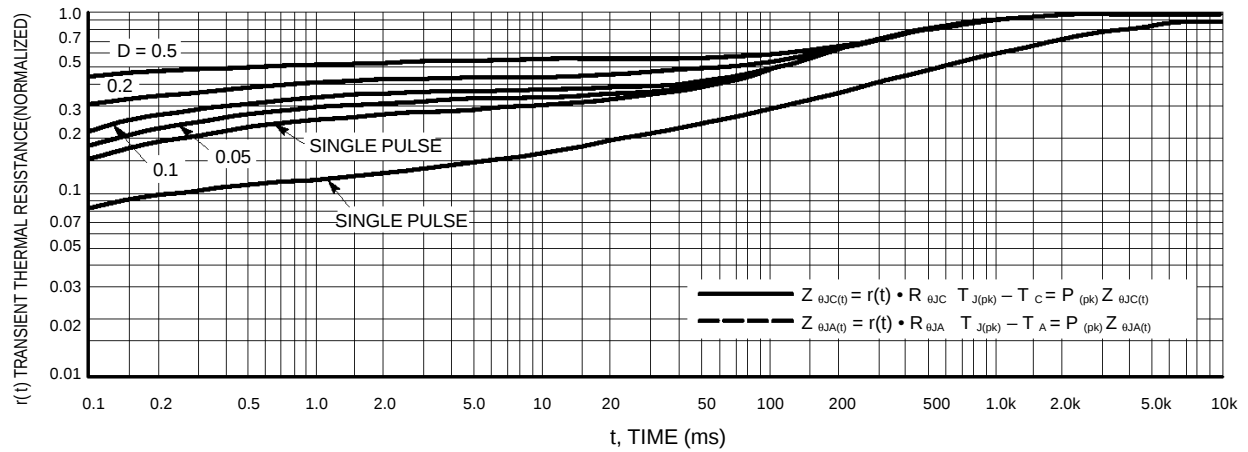


Figure 12. Thermal Response

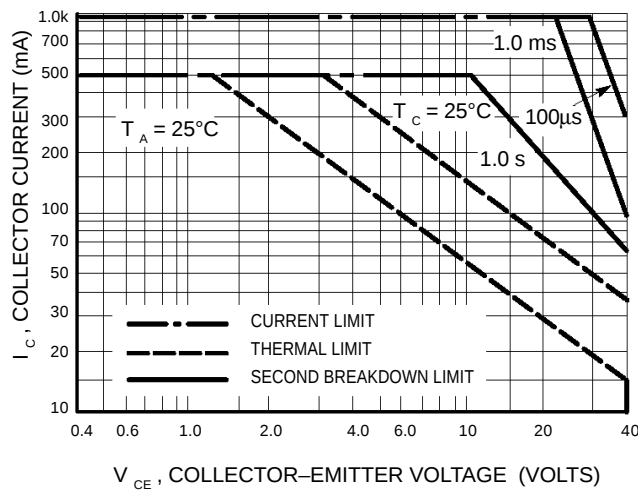
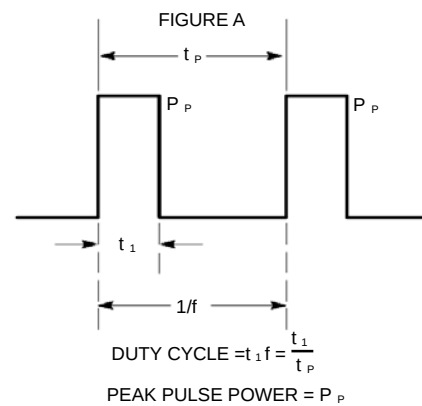


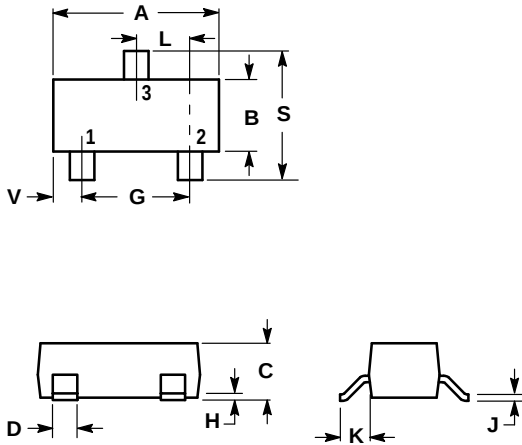
Figure 13. Active Region Safe Operating Area



Design Note: Use of Transient Thermal Resistance Data

LMBTA13LT1G LMBTA14LT1G

SOT-23

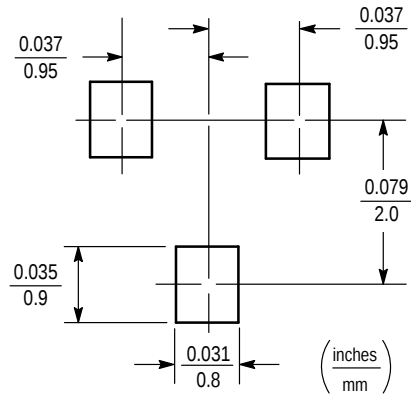


NOTES:

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.

DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.1102	0.1197	2.80	3.04
B	0.0472	0.0551	1.20	1.40
C	0.0350	0.0440	0.89	1.11
D	0.0150	0.0200	0.37	0.50
G	0.0701	0.0807	1.78	2.04
H	0.0005	0.0040	0.013	0.100
J	0.0034	0.0070	0.085	0.177
K	0.0140	0.0285	0.35	0.69
L	0.0350	0.0401	0.89	1.02
S	0.0830	0.1039	2.10	2.64
V	0.0177	0.0236	0.45	0.60

- PIN 1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.